

СОДЕРЖАНИЕ

Том 52, номер 4, 2023

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Томографии детекторов с учетом мертвого времени

*Ю. И. Богданов, К. Г. Катамадзе, Н. А. Борщевская, Г. В. Авосоянц,
Н. А. Богданова, С. П. Кулик, В. Ф. Лукичев*

249

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование кремниевых полевых с полностью охватывающим затвором нанотранзисторов с высоким k подзатворного диэлектрика

Н. В. Масальский

256

Влияние граничных условий на квантовый магнетотранспорт в тонкой пленке

И. А. Кузнецова, О. В. Савенко, Д. Н. Романов

262

НАДЕЖНОСТЬ

Исследование чувствительной области МОП-транзистора к воздействию вторичных частиц, возникающих вследствие ионизирующего излучения

А. А. Глушко, С. А. Морозов, М. Г. Чистяков

282

Одиночные структурные повреждения в СБИС

А. И. Чумаков

290

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Концентрация атомов фтора и кинетика реактивно-ионного травления кремния в смесях $CF_4 + O_2$, $CHF_3 + O_2$ и $C_4F_8 + O_2$

А. М. Ефремов, А. В. Бобылев, К.-Н. Kwon

298

ПРИБОРЫ

Влияние структурных дефектов на электрофизические параметры $p-i-n$ -фотодиодов

*Н. С. Ковальчук, С. Б. Ластовский, В. Б. Оджаяев, А. Н. Петлицкий,
В. С. Просолович, Д. В. Шестовский, В. Ю. Явид, Ю. Н. Янковский*

307

Многоуровневые мемристоривные структуры на основе эпитаксиальных пленок $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

Н. А. Тулина, А. Н. Россоленко, И. Ю. Борисенко, А. А. Иванов

315

СЕНСОРЫ

Исследование сенсорных свойств упорядоченных массивов наностержней ZnO для детектирования УФ-излучения

*М. В. Евстафьева, М. А. Князев, В. И. Корепанов, А. Н. Редькин,
Д. В. Роцупкин, Е. Е. Якимов*

322

ТЕХНОЛОГИИ

Влияние мощности магнетронного распыления на осаждение пленок ИТО при комнатной температуре

А. В. Саенко, З. Е. Вакулов, В. С. Климин, Г. Е. Билык, С. П. Малюков

329

Механизмы перераспределения углеродных загрязнений в пленках, сформированных методом атомно-слоевого осаждения

А. В. Фадеев, А. В. Мьяконьких, Е. А. Смирнова, С. Г. Симакин, К. В. Руденко

336